

請求の範囲

- [請求項1] IF_5 と IF_7 とを含有し、前記 IF_5 の含有量が、前記 IF_5 と前記 IF_7 との合計に対して、体積基準で1ppm以上2%以下である、基板処理用ガス。
- [請求項2] 請求項1に記載の基板処理用ガスであって、
前記 IF_5 の含有量が、前記 IF_5 と IF_7 との合計に対して、体積基準で1%以下である、基板処理用ガス。
- [請求項3] 請求項1または2に記載の基板処理用ガスであって、
前記 IF_7 の含有量が、当該基板処理用ガス全体に対して、体積基準で50%以上である、基板処理用ガス。
- [請求項4] 請求項1から3のいずれか1項に記載の基板処理用ガスであって、
 Fe 、 Cr 、 Mn 、 Co 、 Ti 、 Mo 、 Cu および Ni からなる群から選択される一種以上の金属を含有し、含有される前記金属のそれぞれの含有量が、当該基板処理用ガス全体に対して、質量基準で100ppb以下である、基板処理用ガス。
- [請求項5] 請求項1から4のいずれか1項に記載の基板処理用ガスであって、
エッチングガスに用いる、基板処理用ガス。
- [請求項6] 請求項1から5のいずれか1項に記載の基板処理用ガスを内部に充填してなる、保管容器。
- [請求項7] 請求項1から5のいずれか1項に記載の基板処理用ガスを用いて、
シリコンをプラズマレスでドライエッチングする基板処理方法。
- [請求項8] シリコンのドライエッチングを10回行った場合に、
エッチング速度の平均値が100nm/min以上であり、
エッチング速度の標準偏差が10以下であることを特徴とする、請求項7に記載の基板処理方法。